

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 3 部門第 4 区分  
【発行日】令和 6 年 3 月 18 日(2024.3.18)

【公開番号】特開 2023-39081(P2023-39081A)  
【公開日】令和 5 年 3 月 20 日(2023.3.20)  
【年通号数】公開公報(特許)2023-052  
【出願番号】特願 2021-146056(P2021-146056)  
【国際特許分類】

C 2 3 C 16/42(2006.01)

10

H 0 1 L 21/28(2006.01)

H 0 1 L 21/285(2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/42

H 0 1 L 21/28 3 0 1 S

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

【手続補正書】

【提出日】令和 6 年 3 月 8 日(2024.3.8)

20

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

前記成膜阻害剤を形成する工程は、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程に先立って、または、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程の際に行われる、請求項 5 または請求項 6 に記載の成膜方法。

【手続補正 2】

30

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 9】

前記チタンシリサイド膜を成膜する工程は、前記還元ガスとして、前記 Si 含有ガスの他に、H<sub>2</sub> ガス、重水素含有ガス、NH<sub>3</sub> ガスの少なくとも 1 種を供給する、請求項 1 から請求項 8 のいずれか一項に記載の成膜方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

40

【補正対象項目名】請求項 15

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 15】

前記成膜阻害剤を形成する工程は、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程に先立って、または、前記チタンシリサイド膜を成膜する工程の際に行われる、請求項 13 または請求項 14 に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 18

50

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 18】

前記チタンシリサイド膜を成膜する工程は、前記還元ガスとして、前記 Si 含有ガスの他に、 $\text{H}_2$  ガス、重水素含有ガス、 $\text{NH}_3$  ガスの少なくとも 1 種を供給する、請求項 11 から請求項 17 のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。

10

20

30

40

50